

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】 第 7 部門第 3 区分
 【発行日】 平成 18 年 9 月 7 日 (2006.9.7)

【公表番号】 特表 2005-535227(P2005-535227A)
 【公表日】 平成 17 年 11 月 17 日 (2005.11.17)
 【年通号数】 公開・登録公報 2005-045
 【出願番号】 特願 2004-526126(P2004-526126)
 【国際特許分類】

H 0 3 F 3/60 (2006.01)

H 0 3 F 3/20 (2006.01)

【F I】

H 0 3 F 3/60

H 0 3 F 3/20

【手続補正書】

【提出日】 平成 18 年 7 月 14 日 (2006.7.14)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 全文

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板と、

集積回路 (I C) と、

複数のトランジスタを含む電力増幅器回路であって、前記複数のトランジスタはそれに接続された伝送線インダクタを有する、電力増幅器回路と、
を備え、前記複数のトランジスタは前記 I C 上に実質的に配置され、前記インダクタは前記基板上に実質的に配置され、前記基板の前記インダクタはワイヤボンドを介して前記 I C の前記トランジスタに接続されている、分布型電力増幅器の構造。

【請求項 2】

セラミック基板と、

前記セラミック基板上の集積回路 (I C) であって、ドレイン、一連のゲート線伝送インダクタに接続されたゲート、及び接地端子に接続されたソースをそれぞれ有する複数のトランジスタ、及び前記複数のトランジスタのうちの 1 つのトランジスタのドレインにそれぞれ接続された複数のドレイン線コンデンサを含む I C と、

前記セラミック基板上に形成された一連のドレイン線伝送インダクタと、

前記セラミック基板上の各ドレイン線伝送インダクタと前記 I C 上の各ドレイン線コンデンサとの間のワイヤボンドの相互接続と、
 を備える分布型電力増幅器の構造。

【請求項 3】

基板と、

前記基板上に形成された集積回路 (I C) であって、トランジスタ及び該トランジスタに接続された伝送線インダクタの第一セットを含む分布型電力増幅器回路の第一部分を含む I C と、

前記基板上に形成され、かつワイヤボンドの相互接続により、前記 I C のトランジスタに接続された伝送線インダクタの第二セットと、
 を備える分布型電力増幅器の構造。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】分布型電力増幅器のためのハイブリッド構造